



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

H1684

对应国外型号
2SD1684

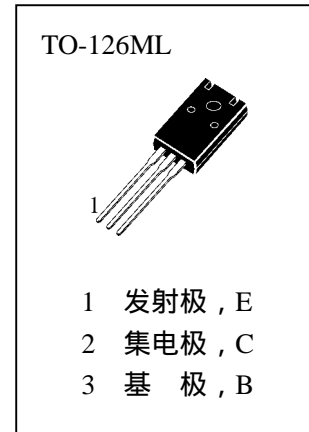
主要用途

低频功率放大、中速开关

极限值 ($T_a=25$)

T_{stg} ——贮存温度.....	-55~150
T_j ——结温.....	150
P_C ——集电极耗散功率 ($T_c=25$)	10W
V_{CB0} ——集电极—基极电压.....	120V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压.....	100V
V_{EB0} ——发射极—基极电压.....	6V
I_C ——集电极电流.....	1.5A

外形图及引脚排列



电参数 ($T_a=25$)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
BV_{CB0}	集电极—基极击穿电压	120			V	$I_C=10\mu A, I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	100			V	$I_C=1mA, R_{BE}=\infty$
BV_{EB0}	发射极—基极击穿电压	6			V	$I_E=10\mu A, I_C=0$
I_{CB0}	集电极—基极截止电流			100	nA	$V_{CB}=100V, I_E=0$
I_{EB0}	发射极—基极截止电流			100	nA	$V_{EB}=4V, I_C=0$
$h_{FE}(1)$	直流电流增益	100		400		$V_{CE}=5V, I_C=100mA$
$h_{FE}(2)$		30				$V_{CE}=5V, I_C=1A$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压		0.1	0.3	V	$I_C=500mA, I_B=50mA$
$V_{BE(sat)}$	基极—发射极饱和电压		0.85	1.2	V	$I_C=500mA, I_B=50mA$
t_{ON}	导通时间		80		nS	按特定测试电路
t_{STG}	贮存时间		1000		nS	
t_F	下降时间		50		nS	
f_T	特征频率		120		MHz	$V_{CE}=10V, I_C=50mA$
C_{ob}	输出电容		11		pF	$V_{CB}=10V, f=1MHz$

分档及其标志

R	S	T
100—200	140—280	200—400